

域格高通平台 TD3B 型号说明

一、命名规则

C L M 9 2 0 T D 3 B A U C M X

第十五、十六位为功能说明

MX-单主集 **MD**-主集+分集 **MG**-单主集+GPS **DG**-主集+分集+GPS

第十四位表示flash大小

C-1+1(1Gb NAND+1Gb RAM) , **S**-2+1(2Gb NAND+1Gb RAM)

T-4+2(4Gb NAND+2Gb RAM)

第十二、十三位表示频段信息

AU-欧洲/澳洲, **NA**-美洲

第十一位表示PCB版本

B-PCB2.0 (**A**-PCB1.0, **B**-PCB2.0, **C**-PCB3.0... 以此类推)

第十位代表模块的封装形式

3-LCC

第九位代表模块类别:

D-可支持全球频段

第八位代表模块采用的主控平台

T-MDM9207

第七位为空格

第四、五、六位**920**三个数字组合为模块系列型号

第三位**M** (模块英文module的首字母) 代表模块

第二位**L**代表4G LTE制式

第一位**C**, 所有4G模块统一以**C**字母开头

域格高通平台 TD3B 型号说明

二、采购编码表

| 域格高通平台 CLM920 TD3B 主推 OC 说明表 | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------|----|----|------|---|
| 模块 | 频段说明 | 频段 | flash | 主集 | 分集 | GNSS | 备注 |
| CLM920 TD3BAUCMX | 欧洲/澳洲 | TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800 | 1+1 | √ | × | × | flash 中 1+1 表示 1Gb NAND+1Gb RAM |
| CLM920 TD3BAUCMD | | | | √ | √ | × | |
| CLM920 TD3BAUCMG | | | | √ | × | √ | |
| CLM920 TD3BAUCDG | | | | √ | √ | √ | |
| CLM920 TD3BNACMX | 美洲 | TDD LTE: B38/B40/B41 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | | √ | × | × | |
| CLM920 TD3BNACMD | | | | √ | √ | × | |
| CLM920 TD3BNACMG | | | | √ | × | √ | |
| CLM920 TD3BNACDG | | | | √ | √ | √ | |